



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

H669A

对应国外型号
2SD669A

主要用途

作低频功率放大。

极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度	-55~150
T_j ——结温	150
P_C ——集电极功率耗散 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	20W
P_C ——集电极功率耗散 ($T_A=25^\circ\text{C}$)	1W
V_{CBO} ——集电极—基极电压	180V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压	160V
V_{EBO} ——发射极—基极电压	5V
I_C ——集电极电流	1.5A

电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
I_{CB0}	集电极—基极截止电流			10	μA	$V_{\text{CB}}=160\text{V}$, $I_E=0$
H_{FE1}	直流电流增益	60		200		$V_{\text{CE}}=5\text{V}$, $I_C=150\text{mA}$
H_{FE2}		30				$V_{\text{CE}}=5\text{V}$, $I_C=500\text{mA}$
$V_{\text{CE(sat)}}$	集电极—发射极饱和压降			1	V	$I_C=500\text{mA}$, $I_B=50\text{mA}$
BV_{CB0}	集电极—基极击穿电压	180			V	$I_C=1\text{mA}$, $I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	160			V	$I_C=10\text{mA}$, $R_{\text{EB}}=$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	5			V	$I_E=1\text{mA}$, $I_C=0$
f_T	特征频率		140		MHz	$V_{\text{CE}}=5\text{V}$, $I_C=150\text{mA}$
C_{ob}	输出电容		14		pF	$V_{\text{CB}}=10\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{MHz}$

外形图及引脚排列

TO-126ML



1—发射极, E
2—集电极, C
3—基 极, B

分档及其标志

B

C

60—120

100—200